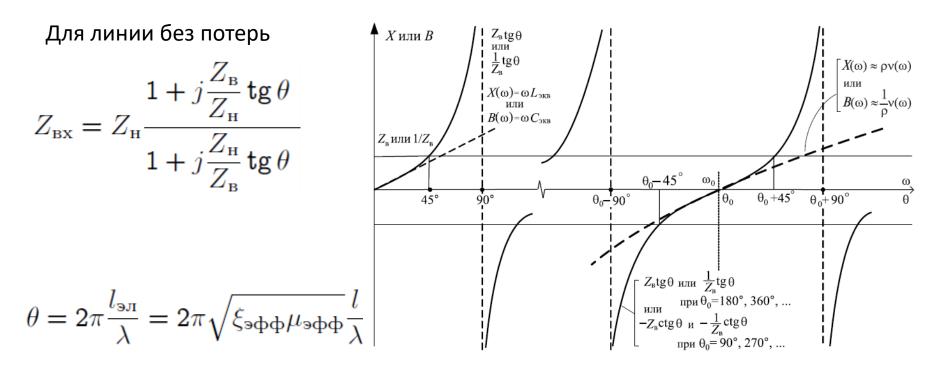
# Лекция 6. Согласующие (трансформирующие цепи)

## Цепи связи на распределенных L- и C-элементах.

цепи связи на сосредоточенных L- и C-элементах удается реализовать на частотах до 1...2 ГГц, а при малых уровнях мощности вплоть до  $\approx 10$  ГГц. Наряду с этим примерно со 100...300 МГц их частично (в первую очередь индуктивности) или полностью реализуют на отрезках линий, главным образом на несимметричных полосковых и микрополосковых линиях.

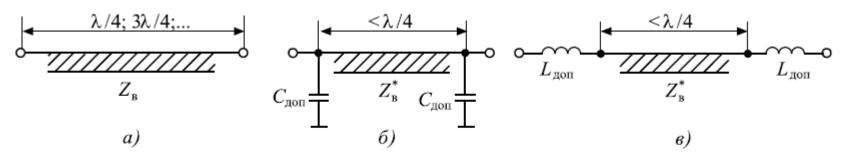


При относительно низкоомной нагрузке  $|Z_{\rm H}|/Z_{\rm B}<0,3$  и малой эквивалентной длине  $l_{\scriptscriptstyle {\rm 9.T}}<\lambda/8$  ( $\theta<\pi/4$  или  $<\!45^\circ$ ), когда  ${\rm tg}\,\theta<1,$ 

$$Z_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}} pprox j Z_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}} \mathsf{tg} \theta + Z_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} pprox j \omega L_{\scriptscriptstyle \mathrm{9KB}} + Z_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$$

При относительно высокоомной нагрузке  $|Z_{\rm H}|/Z_{\rm B}>3$  и малой эквивалентной длине  $l_{\scriptscriptstyle 
m BH}<\lambda/8$  ( $heta<\pi/4$  или  $<\!45^\circ$ ), когда  ${
m tg}\, heta<1$ , в (3.326) можно

$$Y_{ ext{BX}} = rac{1}{Z_{ ext{BX}}} = rac{1}{Z_{ ext{H}}} \left[ 1 + j rac{Z_{ ext{H}}}{Z_{ ext{B}}} \operatorname{tg} heta 
ight] \\ pprox j \omega C_{ ext{
m 9KB}} + rac{1}{Z_{ ext{H}}}, \quad ext{где} \qquad C_{ ext{
m 9KB}} = rac{1}{\omega Z_{ ext{
m B}}} \operatorname{tg} heta pprox rac{1}{\omega Z_{ ext{
m B}}} heta$$

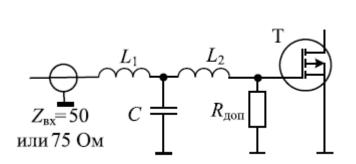


. Схемы «инвертирующих» цепочек на линиях  $\lambda/4$ ,  $3\lambda/4,...$  (a) и  $<\lambda/4$  (6, 6)

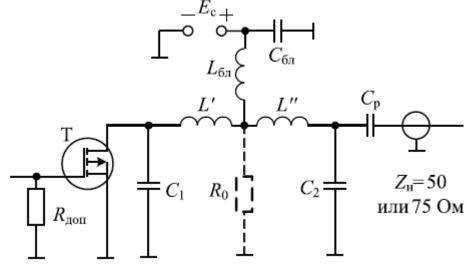
линия осущест-

вляет обратную, инверсную трансформацию нагрузочного сопротивления  $Z_{\rm H}$  в  $Z_{\rm H}^*=Z_{\rm B}^2/Z_{\rm H}$  или проводимости  $Y_{\rm H}$  в  $Y_{\rm H}^*=1/Z_{\rm B}^2Y_{\rm H}$ , т. е. такие отрезки линий эквивалентны инверсным Т- и П-цепочкам

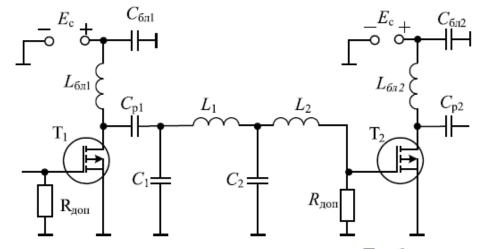
# Схемотехника узкополосных (резонансных ) УМ



 $R_{
m доп}$ , в сопротивление 50 или 75 Ом.

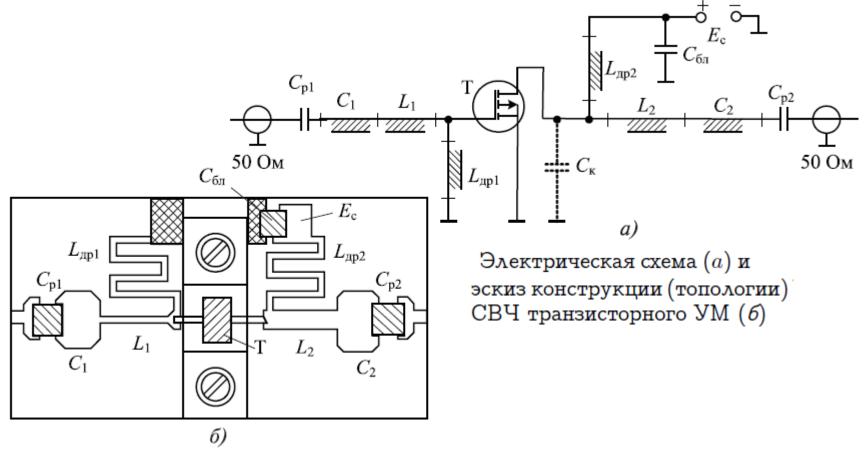


50 или 75 Ом в  $R_{\scriptscriptstyle \mathrm{9KB\,HOM}}$  транзистора



последовательно включенные  $\Gamma$ -образные цепочки трансформируют (повышают) резистивную составляющую входного сопротивления второго транзистора с учетом  $R_{\rm доп}$  до номинального нагрузочного сопротивления первого

## Схемотехника узкополосных (резонансных ) УМ



: входное сопротивление дросселя, короткозамкнутого на другом конце, близко к бесконечному  $(Z_{\text{BX}} \approx jZ_{\text{B}} \operatorname{tg} \theta \approx \infty)$ .

Для разомкнутой линии  $\lambda/4$   $(Z_{ ext{BX}} pprox -jZ_{ ext{B}}\operatorname{ctg} heta pprox 0)$  - реализует **Сбл** 

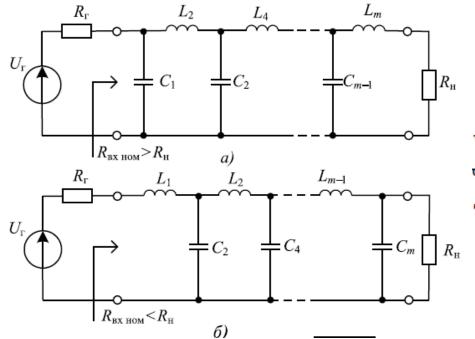
## Широкодиапазонные ЦС и УМ

#### Основные требования

- 1. Создавать во всем диапазоне от  $\omega_{\rm H}$  до  $\omega_{\rm B}$  одинаковое нагрузочное сопротивление для ЭП данного УМ по первой гармонике.  $Z_{\rm экв}(\omega) \approx R_{\rm экв}(\omega) \approx R_{\rm экв}(\omega)$
- 2. Учитывать реактивные составляющие и их частотные зависимости во входных и выходных сопротивлениях (проводимостях) ЭП, обусловленных их входными и выходными емкостями и индуктивностями выводов.
- входными и выходными емкостями и индуктивностями выводов. 3. С ростом рабочей частоты у ЭП может заметно снижаться коэффициент усиления по мощности  $K_P$ . Поэтому входные цепи каскадов УМ, построенных на таких ЭП, должны одновременно строиться и как цепи коррекции АЧХ, обес-
- 4. При работе ЭП в мощных УМ с отсечкой тока должна обеспечиваться фильтрация высших гармонических составляющих его выходного тока в нагрузке. Эта проблема принципиально имеет рещение, если рабочий диапазон не превышает октавы ( $K_f = \omega_{\rm B}/\omega_{\rm H} < 2$ ). ФНЧ либо ПФ с  $K_f < 2$ 1

требуется дополнительное подавление высших гармоник, например, на выходе оконечного каскада усилительного тракта, то тогда устанавливают дополнительные фильтры на отдельные поддиапазоны, каждый с коэффициентом перекрытия по частоте менее октавы  $K_f \leqslant 1,7\dots 1,8$ 

### Широкодиапазонные ЦС

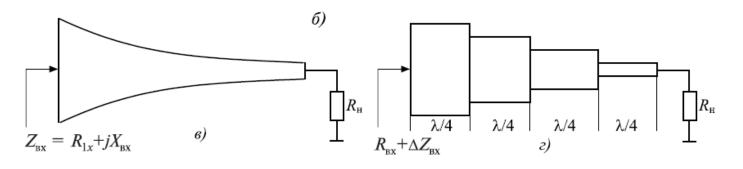


соединение m/2  $\Gamma$ -цепочек  $\Phi$ НЧ-трансформаторы проектируются на заданную АЧХ в полосе пропускания чем больше коэффициент  $K_f = \omega_{\scriptscriptstyle \rm B}/\omega_{\scriptscriptstyle \rm H}$ , чем меньше допустимые отклонения  $|\Delta Z_{\scriptscriptstyle \rm BX}|$  тем оказывается больше расчетное m

На практике стараются, чтобы число L и С не превышало 6 или 8.

Практически реализуем при

коэффициентах трансформации ( $r\leqslant 10$  или  $r\geqslant 0,1$ ) перекрытия по частоте ( $K_f\leqslant 2\dots 3$ ).



На СВЧ синтезируют ФНЧ трансформаторы на МПЛ с плавным в) и ступенчатым переходом

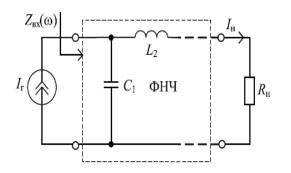
### Широкодиапазонные ЦС. Проектирование (синтез)

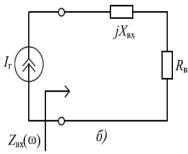
Варианты синтеза различных типов фильтров по рабочим параметрам для трех случаев: работы от источника тока  $I_{\Gamma}(\omega)=\mathrm{const}\;\mathrm{c}\;R_{\Gamma}=\infty,$ источника напряжения  $U_{\scriptscriptstyle \Gamma}(\omega)={\rm const}\;{\rm c}\;R_{\scriptscriptstyle \Gamma}=0$  и

 $U_{\Gamma}(\omega) = \text{const c резистивным внутренним сопротивлением } R_{\Gamma}(\omega) = \text{const.}$ 

Рассмотрим 1, т.к. ЭП в недонапряжённом режиме – источник тока  $I_{\Gamma}(\omega)=\mathrm{const}\;\mathrm{c}\;R_{\Gamma}=\infty$ 

$$I_{\Gamma}(\omega) = \text{const c } R_{\Gamma} = \infty$$

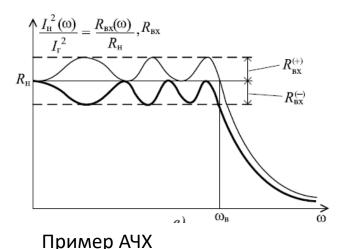


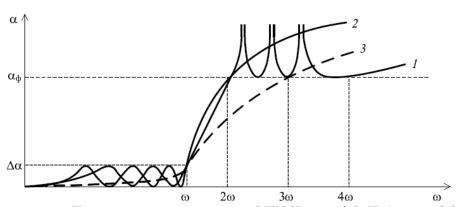


АЧХ фильтра  $|K_1(\omega)|^2 = |I_H(\omega)|^2/I_F^2$ Считаем, что ФНЧ без потерь

$$P_{\text{BX}}(\omega) = 0.5I_{\text{r}}^2 R_{\text{BX}}(\omega) = P_{\text{H}}(\omega) = 0.5I_{\text{H}}^2(\omega) R_{\text{H}}$$
  
 $R_{\text{BX}}(\omega) = R_{\text{H}} |I_{\text{H}}(\omega)|^2 / I_{\text{r}}^2 = R_{\text{H}} |K_1(\omega)|^2$ 

Синтез ФНЧ по параметрам r,  $\Delta$ Rвx,  $\omega$ в,  $\alpha$ с использованием таблиц и специальных программ



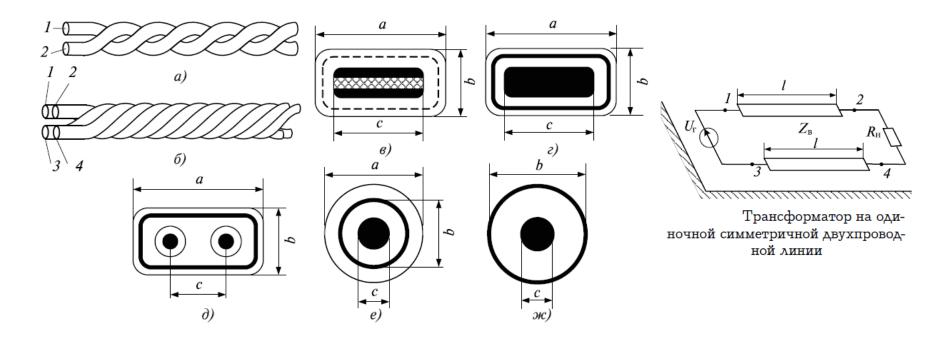


Частотные характеристики ФНЧ Кауэра (1), Чебышева (2) и Баттерворта (3)

## Широкодиапазонные ЦС на трансформаторах

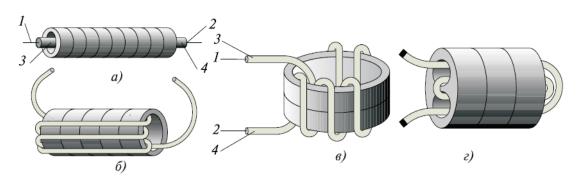
Для трансформации относительно низких сопротивлений в диапазоне частот от 0,1...1,0 МГц до 100...2000 МГц и выше используют трансформаторы на отрезках длинных линий или просто трансформаторы на линиях  $(T\Lambda)$ 

Трансформаторы на линиях, или *трансформаторы Рутрофа*, по имени инженера, который их предложил, выполняют на симметричных двухпроводных, а также на коаксиальных и полосковых линиях.



 $Z_{ ext{\tiny B}}$  от  $2\dots 3$  Ом, до  $100\dots 200$  Ом

со стандартными волновыми сопротивлениями 50 и 75 Ом

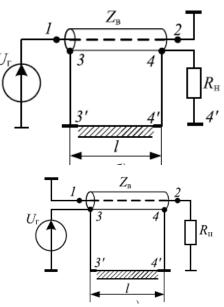


Конструкции трансформаторов на линиях

можно включать проводники всех линий с одной стороны (по входу) последовательно, а с другой стороны (по выходу) параллельно либо наоборот. В итоге при одинаковом числе линий можно получать разные схемы трансформаторов по коэффициенту трансформации сопротивлений (напряжения и тока), симметричные или несимметричные по входу и по выходу относительно корпуса.

Используя последовательное и параллельное включение по входу и выходу : нескольких трансформаторов 1:1, можно обеспечивать коэффициент трансформации отличный от единицы как в сторону его увеличения, так и в сторону понижения. Другими словами, можно строить повышающие и понижающие трансформаторы с  $K_U = U_2/U_1 = U_{\rm H}/U_{\rm F}$  отличным от единицы (здесь принято

в трансформаторах на линиях на высоких частотах (выше 100...200 МГц) можно также обходиться без дополнительного изолятора на магнитопроводе (феррите)



с «инверсией» фазы 1:-1.

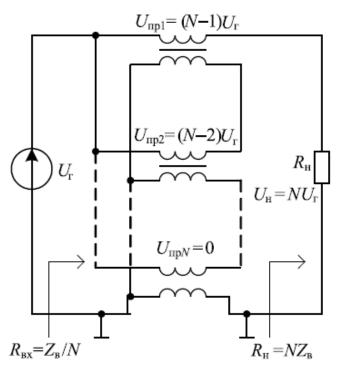
Для уменьшения шунтирования линией Rн и Rвх

$$2\pi f_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} L_{\scriptscriptstyle \mathrm{9KB}}^{(1)} > (10...20) R_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}};$$

$$2\pi f_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} L_{\scriptscriptstyle \mathrm{9KB}}^{(2)} > (10\dots 20) R_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$$

индуктивность проводников составляет  $7...10 \ h\Gamma h/cm$ .

При  $K_f$  от 10 до 100 и выше - феррит с  $\mu$ , достигающим величин 2000...5000



Трансформаторы на N одинаковых линиях

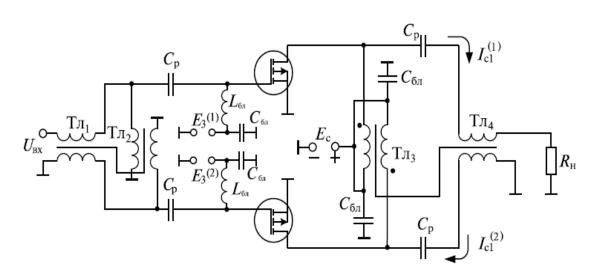
$$R_{\text{BX}} = Z_{\text{B}}/N; \quad R_{\text{H}} = NZ_{\text{B}}.$$

Отсюда следует

$$R_{\text{BX}} = R_{\text{H}}/N^2; \quad Z_{\text{B}} = \sqrt{R_{\text{BX}}R_{\text{H}}}.$$

Коэффициент трансформации r - дискретный

$$R_{\rm H}/R_{\rm BX} = N^2 = 1; 4; 9; 16; \dots,$$



ТЛ1 и для перехода от несимметричного вх. к 2-х тактной схеме входа. ТЛ4 — наоборот от 2-х тактной схемы к несимметричному выходу.

ТЛЗ — замыкает токи чётных гармоник и не влияет на нечётные

$$Z_{{\scriptscriptstyle \mathrm{B}4}} = R_{{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}} \qquad R_{{\scriptscriptstyle \mathrm{9KB}}} = 0.5 R_{{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}}$$
  $Z_{{\scriptscriptstyle \mathrm{B}3}} = (0.5 \dots 1.0) R_{{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}}$ 

Электрическая схема двухтактного УМ на трансформаторах-линиях

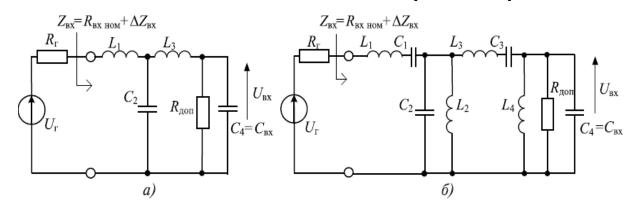
 $l_{\scriptscriptstyle \mathrm{ЭЛ}}$  выбирается не более  $(0,05\dots0,1)\lambda$ .

по входу транзисторы шунтируют дополнительными резисторами  $R_{\mathrm{доп}}$ 

При  $K_f = \omega_{\text{в}}/\omega_{\text{н}}$  не более 2... 4 большей частью перед каждым транзистором устанавливают простейшие LC-цепочки. Они совместно с резистивной составляющей входного сопротивления самих транзисторов и параллельно включаемых резисторов  $R_{\text{доп}}$  создают в рабочей полосе частот от  $\omega_{\text{н}}$  до  $\omega_{\text{в}}$ , близкое к резистивному, нагрузочное сопротивление для трансформатора  $\text{Т}\Lambda_1$ .

## Широкодиапазонные ЦС (коррекции АЧХ) на входе ЭП

#### Полевые транзисторы



Коэффициент шунтирования вх. ЭП ёмкостью Свх

$$\alpha_m = (\omega_{\scriptscriptstyle \rm B} - \omega_{\scriptscriptstyle \rm H}) C_m R_{\scriptscriptstyle \rm ДО\Pi} = (\omega_{\scriptscriptstyle \rm B} - \omega_{\scriptscriptstyle \rm H}) C_{\scriptscriptstyle \rm BX} R_{\scriptscriptstyle \rm ДО\Pi},$$

Входные согласующие ЦС УМ на полевом транзисторе: a — низкочастотные;  $\delta$  — полосовые

Для снижения потерь на Rдоп при тех же условиях усложняют ЦС (порядок ФНЧ или ПФ)

МОП-транзистор по схеме ОИ при его работе в недонапряженном, вплоть до граничного режима, на относительно низких радиочастотах, ориентировочно не выше  $(0,5\dots0,8)\omega_{\max}$ , можно не считаться со снижением его усилительных свойств (с частотной зависимостью крутизны проходной характеристики). Одновременно в этих транзисторах можно не учитывать индуктивности выводов, реакцию со стороны выхода на входную цепь, в частности обратную связь через проходную емкость. Поэтому по входу его можно в первом приближении представить эквивалентной емкостью  $C_{\text{вх}}$ 

## Широкодиапазонные ЦС (коррекции АЧХ) на входе ЭП

#### Биполярные транзисторы

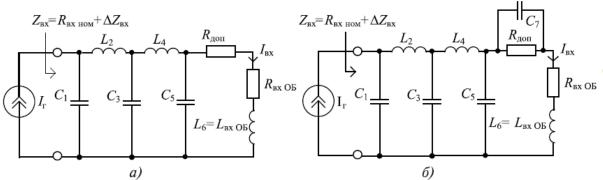


Рис. 3.56. Входные согласующие ЦС УМ на биполярном транзисторе с ОБ: a-m=2,4,6; 6-m=3,5,7

В УМ на биполярных транзисторах при включении с общей базой (ОБ) при построении входных цепей широкодиапазонных ЦС во всем интервале частот до  $\omega\approx 0.8\omega_{\scriptscriptstyle \rm T}$  можно не считаться со снижением модуля коэффициента усиления по току  $h_{216}(\omega)$ , приняв его равным 1.

в УМ величина  $K_P$  должна быть не ниже  $5\dots 10$ , т. е.

отношение сопротивлений должно быть  $R_{ ext{\tiny 9KB}}/(R_{ ext{\tiny BXOB}} + R_{ ext{\tiny ДОП}}) > 5 \dots 10.$ 

Оптимальные величины всех реактивных элементов  $(C_1,L_2,C_3,L_4,C_5$  и  $C_7)$  и сопротивления  $R_{\rm доп}$  подбираются, а фактически синтезируются так, чтобы в полосе пропускания от 0 до  $\omega_{\rm B}$  обеспечивалась равноколебательная (чебышевская)

#### Применяют

на частотах до 1...2 ГГц.

#### Требуется обеспечить

ток  $I_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}}(\omega) pprox \mathrm{const}$  на индуктивности  $L_m =$ 

 $= L_{\text{BXOF}}$ 

 $\alpha_m = (\omega_{\text{\tiny B}} - \omega_{\text{\tiny H}}) L_{\text{\tiny BXOE}} / R_{\text{\tiny BXOE}}.$ 

**R**вхОБ очень мало (ед., доли Ом)

Для **↓** α вводят Rдоп

Но при этом ↓к.п.д. *Кр* 

$$K_P = \frac{P_{{\scriptscriptstyle {
m H}}1}}{P_{{\scriptscriptstyle {
m BX}}}} = \frac{0.5I_{{\scriptscriptstyle {
m K}}}^2R_{{\scriptscriptstyle {
m 9KB}}}}{0.5I_{{\scriptscriptstyle {
m 9}}}^2(R_{{\scriptscriptstyle {
m BXOS}}}+R_{{\scriptscriptstyle {
m ДО\Pi}}})} pprox rac{R_{{\scriptscriptstyle {
m 9KB}}}}{R_{{\scriptscriptstyle {
m BXOS}}}+R_{{\scriptscriptstyle {
m ДО\Pi}}}}$$

Т.к. Іэ≈ Ік

### Выходные фильтрующие системы

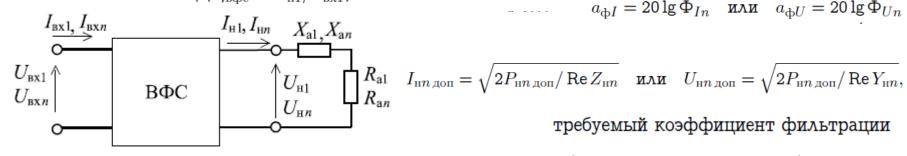
Требования ЭМС. В зависимости от диапазона частот и уровня мощности передатчика на основной частоте  $P_{\rm H1}$  оговаривается допустимое значение мощности побочных излучений — абсолютное  $P_{\text{н}n\,\text{доп}}$  либо относительное, выраженное в децибелах  $10\lg(P_{{\scriptscriptstyle {
m H}}n\,{\scriptscriptstyle {
m ДОП}}}/P_{{\scriptscriptstyle {
m H}}1})$ .  $\perp$ 

Поскольку требования к фильтрации высших гармоник, начиная со 2-й, находятся в пределах от самых минимальных -(30...40) дБ до -(60...80) дБ и выше, ВФС обычно выполняются в виде многозвенных фильтров.

Коэффициент фильтрации по току и напряжению

$$\Phi_{In} = rac{|I_{ ext{BX}n}|}{|I_{ ext{H}n}|}$$
 или  $\Phi_{Un} = rac{|U_{ ext{BX}n}|}{|U_{ ext{H}n}|},$ 

ВФС должна вносить на основной частоте малые потери мощности, т. е. обеспечивать высокий КПД  $\eta_{\rm вфс} = P_{\rm H1}/P_{\rm вх1}$ ,  $a_{\Phi I} = 20\lg\Phi_{In}$  или  $a_{\Phi U} = 20\lg\Phi_{Un}$ 



требуемый коэффициент фильтрации

$$\Phi_{I_{n_{\mathrm{TD}}}} = I_{\mathrm{BX}n}/I_{\mathrm{H}n}$$
 или  $\Phi_{U_{n_{\mathrm{TD}}}} = U_{\mathrm{BX}n}/U_{\mathrm{H}n}$ .

$$m=5$$
 $m=5$ 
 $m=5$ 
 $m=5$ 
 $m=5$ 
 $m=3$ 
 $m=3$ 

Пример зависимости КПД от коэффициента фильтрации для  $\Pi$ -контура (m=3) и двойного  $\Pi$ -контура (m=5) $Q_{xx} = Q_L = 250$ :

### Выходные фильтрующие системы. Узкополосные

Достаточно часто передатчики работают на укороченную антенну, когда ее эквивалентная электрическая длина заведомо меньше  $\lambda/4$ .

 $X_{\rm a}=1/\omega C_{\rm a}$ . При этом согласующая цепь должна скомпенсировать емкостную составляющую  $X_{\rm a}$  и трансформировать резистивную составляющую  $R_{\rm a}$ , как правило, только в сторону повышения до  $R_{\rm H}$  (или  $R_{
m 9KB}$ ).

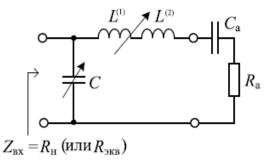
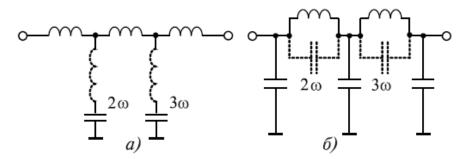


Схема согласующего устройства

Поскольку требуется отфильтровывать только дискретные частоты — высшие гармоники  $(2\omega, 3\omega$  и т. д.), то в схеме можно устанавливать дополнительные специальные последовательные или параллельные, (либо одновременно те и другие) резонансные контура, точно настроенные на ту или иную гармонику.



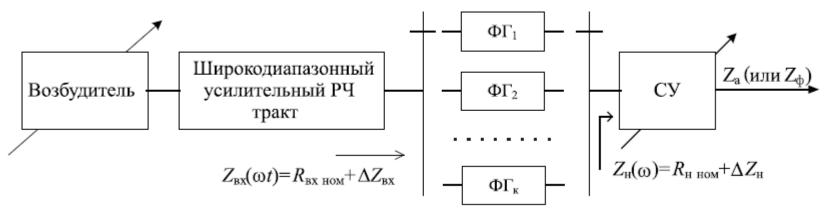
Схемы включения дополнительных контуров, настроенных на высшие гармоники

$$Z_{\text{посл}} = \rho_{\text{посл}}/Q_{xx} \to 0$$
  
 $R_{\text{пар}} = \rho_{\text{пар}}Q_{xx} \to \infty$ 

Фильтры «дырки» а), Фильтры «пробки» б)

Дополнительные узкополосные режекторные фильтры резко увеличивают фильтрацию данной высшей гармоники  $n\omega$ . В результате при одном и том же уровне фильтрации это позволяет существенно уменьшить суммарные потери в LC-элементах как основного ВФС, так и в LC элементах дополнительных режекторных фильтров.

## Выходные фильтрующие системы. Широкодиапазонные



Отдельные i-е фильтры обычно проектируются как многоэлементные ФНЧ без трансформации нагрузочного сопротивления ( $R_{\text{вхном}} \approx R_{\text{н ном}}$ ). Часто их называют просто фильтрами гармоник ( $\Phi\Gamma$ ).

частота  $\omega_{{}_{{
m H}i}}$  не может быть менее  $0,5\omega_{{}_{{
m B}i}}$  и коэффициент перекрытия по частоте каждого i-го фильтра  $K_{fi}=\omega_{{}_{{
m B}i}}/\omega_{{}_{{
m H}i}}$  теоретически не может превышать два, а практически не более 1,8

Фильтр проектируется на неравномерность АЧХ  $\Delta a$  в рабочей полосе пропускания от  $\omega_{{
m H}i}$  до  $\omega_{{
m B}i}$  так, чтобы обеспечивался КСВ $_{\Phi}$  на входе фильтра не выше 1,1...1,3 при номинальном нагрузочном сопротивлении  $R_{{
m H\, Hom}}$ .

Обычно 
$$K_{f1}=K_{f2}=\ldots=K_{fi}=\ldots=K_{fk}$$
. Зная диапазон РПдУ  $K_{f\pi}=f_{{\scriptscriptstyle {
m BH}}}/f_{{\scriptscriptstyle {
m HH}}}$ 

Число фильтров:  $k = \lg K_{f\pi} / \lg K_{fi}$